

Intel : la première mémoire SRAM en 45 nano-mètres arrive

En adoptant la technologie 45 nano-mètres sur ses mémoires SRAM, Intel affiche sa capacité à doubler la densité des transistors par rapport à sa technologie 65 nm. Et il augmente de 20 % les vitesses de commutation.

Autre performance que retiendra l'industrie, la réduction des courants de fuite. Intel annonce ainsi réduire de 30 % la consommation du composant. Pour se représenter la technologie en 45 nm, il faut rappeler qu'à taille équivalente, c'est-à-dire 119 mm², le procédé en 130 nm ne permet de stocker que 18 Mo de données. En réduisant la taille de ses composants en 45 nm, Intel peut stocker, sur la même surface, 153 Mo. Si on prend en compte les cycles de production des nouveaux produits chez le fondeur, les premiers circuits de mémoire SRAM en 45 nm devraient entrer en production à grande échelle vers la fin 2007.